

Nanlin Wang

技术顾问

楠林是专利组的技术顾问。



业务领域

专利

教育背景

爱荷华州立大学，博士，2006 年

清华大学，硕士，2000 年

中南大学，学士，1997 年

办公室

华盛顿，哥伦比亚特区 202.350.3076

电话

电子邮件

Nanlin.Wang@afslaw.com

楠林在半导体，电路，视频编码，通信和人工智能方面有着丰富的背景。

以前的工作

在加入 ArentFox Schiff 之前，楠林是弗吉尼亚州亚历山大的一家知识产权法律事务所的技术顾问，他负责撰写并申请半导体，视频编码，通信，人工智能和机械领域的的新专利申请。楠林曾在一家全球科技公司担任了十年半导体工艺集成高级工程师。他还曾是一家全球半导体代工厂的工程师。在这些角色中，楠林因其出色的技术贡献获得了认可。

论文

楠林的文章包括：

- Nanlin Wang, Louay Semaan, 合金工艺对 8os DRAM 技术中 NBTI 性能的影响。Micron TLP Journal, 2015
- Nanlin Wang, Vikram Dalal, 使用氮化学退火生产的纳米晶 Si 和器件, Mat. Res. Soc. Symp. Proc., 2005, A20.6.1

- Nanlin Wang 和 Vikram L. Dalal。使用氯化学退火提高非晶硅的稳定性, J. Non-cryst. Solids (2006)
- Nanlin Wang, John Snyder 和 Alan Constant, 通过反应脉冲激光沉积法沉积的 Fe-N 薄膜的相形成和磁性能。J. of Vacuum. Sci. and Tech. 2003, 21(5), 1734-1738.
- Nanlin Wang, Yingjiu Zhang, Jing Zhu。通过 Ni/SiCl₄ 气-液-固反应生长硅纳米线。材料科学快报。2001, 20, 89-91。
- Nanlin Wang, Wei Liu 等。电场对中碳合金钢淬火老化的影响。Scripta Materialia, 2001, 44, 2517-2521。
- Yingjiu Zhang, Nanlin Wang 等。利用漂浮催化剂合成 SiC 纳米棒。固态通信。2001, 118, 595-598。
- Yingjiu Zhang, Nanlin Wang 等。从 Si 或 Si/SiO₂ 混合物合成 Si₃N₄ 和 SiO₂ 纳米线的简单方法。晶体生长杂志, 2001, 233, 803-808。
- Yingjiu Zhang, Nanlin Wang 等。Si₃N₄ 纳米线的可逆弯曲。材料研究杂志。2000, 15(5), 1048-1051。
- Yingjiu Zhang, Nanlin Wang 等。合成纳米线的简单方法。材料化学, 2002, 14, 3564-356。

业余爱好

在工作之余, 楠林喜欢篮球, 电影, 音乐和远足。